

全新推薦！新產品



ROHM全新節能元件！

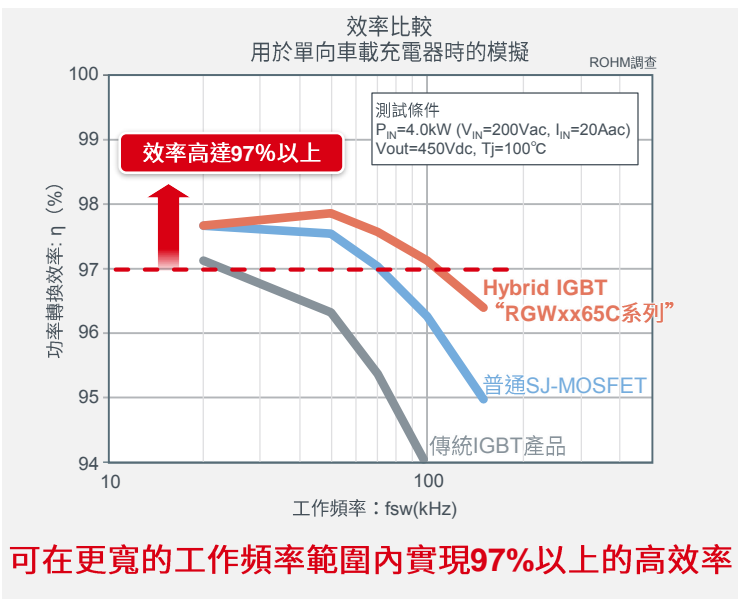
內建SiC蕭特基二極體Hybrid IGBT

RGWxx65C系列 (符合AEC-Q101標準)

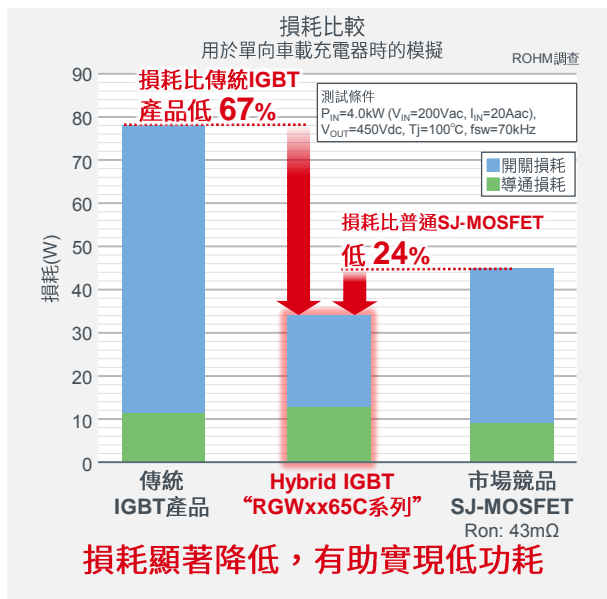
- 效率顯著高於傳統IGBT產品
- 高速IGBT和SiC蕭特基二極體 (SiC SBD) ，導通損耗大幅降低
- 低飽和電壓，效率更高 $V_{CE(sat)}=1.5V$



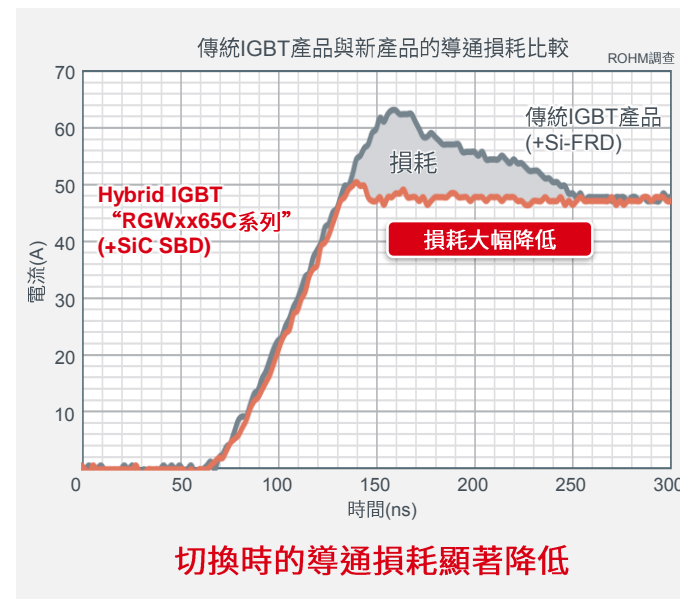
效率改善



損耗改善

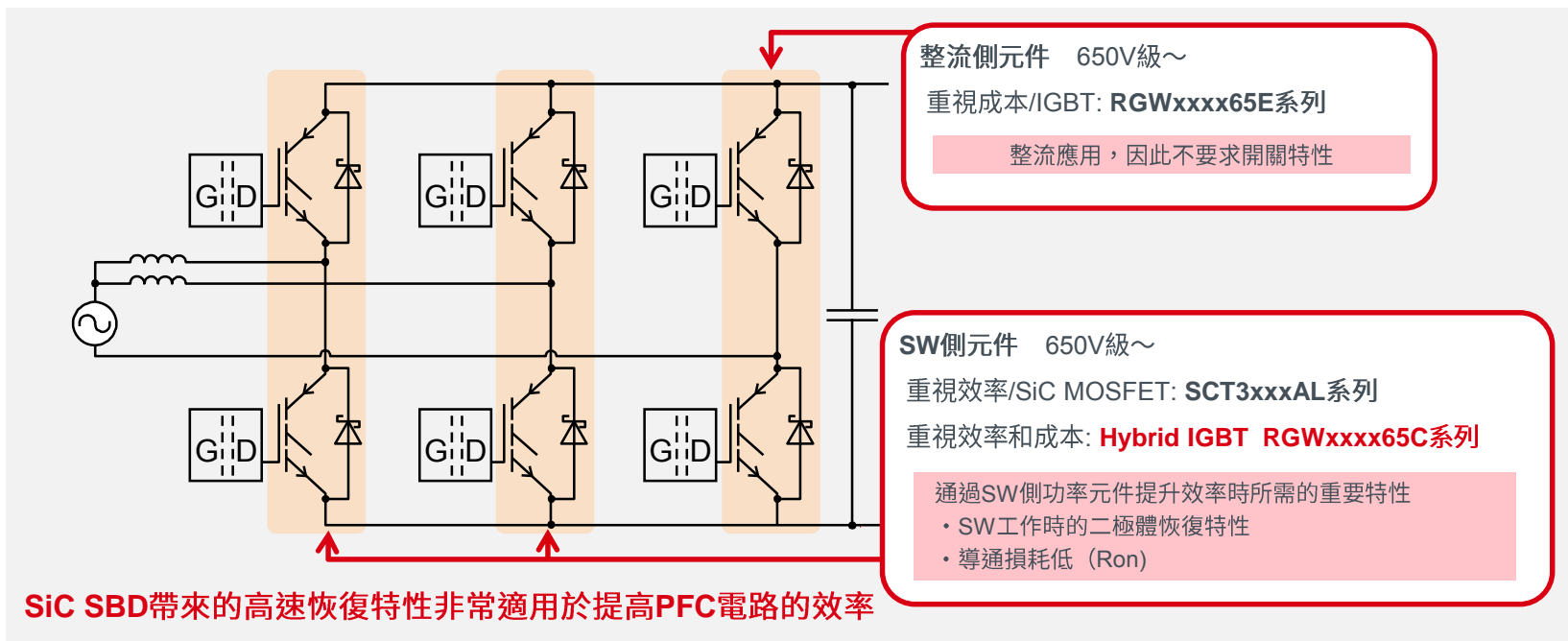


內建SiC SBD可改善恢復特性



用於交錯式圖騰柱PFC功率元件（雙向車載充電器）

應用



車載充電器

車載DC/DC轉換器

太陽能逆變器
(功率調節器)

不斷電系統 (UPS)

產品陣容

插裝型

產品型號	耐壓 V _{CE(S)} (V)	集極電流 I _C (A) T _C =100°C	導通損耗 V _{CE(sat)} Typ (V)	續流 二極體	符合 AEC-Q101		封裝	
					I _F (A) T _C =100°C	V _F (V)		
New RGW60TS65CHR Data Sheet	650	30	1.5	SiC SBD	20	1.35	YES	TO-247N
New RGW80TS65CHR Data Sheet		40	1.5					
New RGW00TS65CHR Data Sheet		50	1.5					

封裝採用JEDEC標準。

表面安裝型

產品型號	耐壓 V _{CE(S)} (V)	集極電流 I _C (A) T _C =100°C	導通損耗 V _{CE(sat)} Typ (V)	續流 二極體	符合 AEC-Q101		封裝	
					I _F (A) T _C =100°C	V _F (V)		
☆RGW40NL65CHRB	650	20	1.5	SiC SBD	12	1.35	YES	TO-263L (LPDL)
☆RGW50NL65CHRB		25	1.5					
☆RGW60NL65CHRB		30	1.5					

封裝採用JEDEC標準。() 內表示ROHM封裝。☆:開發中



ROHM Co., Ltd.

21 Sain Mizosaki-cho, Ukyo-ku,
Kyoto 615-8585 Japan

www.rohm.com.tw

本文件所述之產品規格僅供參考。如需實際使用，請另行索取產品規格書。本文資料所引用的數據，皆為謹慎製作，以期達到正確無誤。若萬一因該數據的錯誤/誤植而引起客戶方面的損害，ROHM恕不負責。關於本資料所記載的技術資料，為產品的典型工作方式及應用電路範例，並不表示將原本屬於ROHM或其他公司的智慧財產權藉由銷售該產品明示地或默示地承諾將使用權利轉移給購買者。因使用上述技術資料所發生的紛爭，ROHM恕不負責。本產品為特定機器、裝置所設計的產品，請務必確定該機器及裝置是否受到海關限制出口使用。

若有產品方面需求請洽

本文件內容以2021年 5月 1日為準。